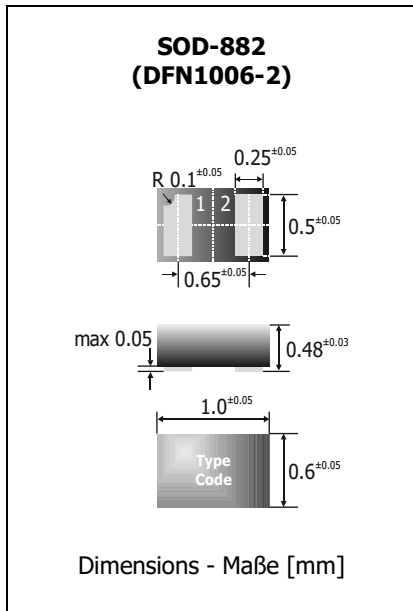


ESDBK3V3 ESD Protection Diodes in SMD ESD-Schutzdioden in SMD	P_{PPM} = 60 W T_{jmax} = 150°C	V_{WM} = 3.3 V V_{BR Min} = 4 V V_{PP} = ± 30 kV
--	--	---

Version 2018-07-19



Typical Applications

ESD protection
Data line and I/O port protection
Commercial grade ¹⁾

Features

Low junction capacitance
Low leakage current
Miniature case outline
Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled	5000 / 7"
Weight approx.	0.0001 g
Case material	UL 94V-0
Solder & assembly conditions	260°C/10s
	MSL = 1



Typische Anwendungen

ESD-Schutz
Schutz von Datenleitungen und Ein-/Ausgängen
Standardausführung ¹⁾

Besonderheiten

Niedrige Sperrschicht-Kapazität
Niedriger Sperrstrom
Miniatur-Gehäusebauform
Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet auf Rolle	
Gewicht ca.	
Gehäusematerial	
Löt- und Einbaubedingungen	

Configuration – Ausführung		Type Code
	Bidirectional – Bidirektional	J3

Maximum ratings ²⁾

Grenzwerte ²⁾

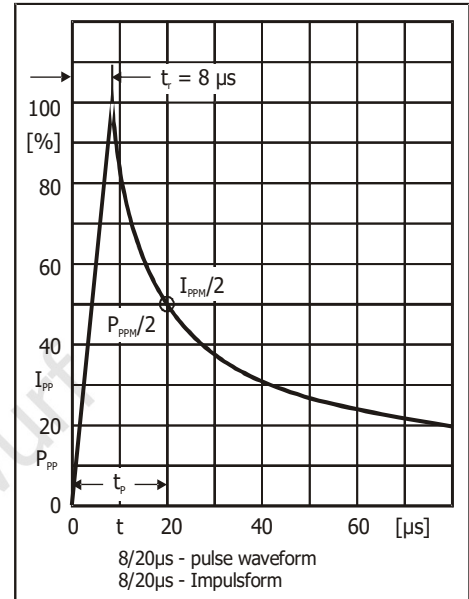
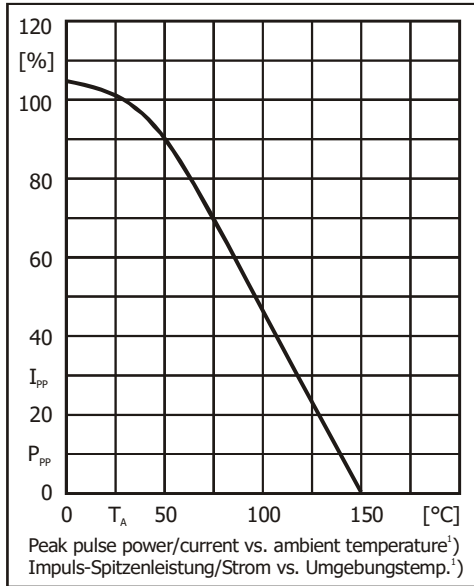
Peak pulse power dissipation (8/20 µs waveform) ³⁾ Impuls-Verlustleistung (8/20 µs Impuls)	P _{PPM}	60 W
Peak pulse power current (8/20 µs waveform) ³⁾ Impuls-Strom (8/20 µs Impuls)	I _{PPM}	7 A
ESD immunity (HBM, air discharge) ESD-Festigkeit (HBM, Luftentladung)	IEC 61000-4-2 V _{PP}	± 30 kV
ESD immunity (contact discharge) ESD-Festigkeit (Kontaktentladung)	IEC 61000-4-2 V _{PP}	± 30 kV
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	T _j T _s	-50...+150°C -50...+150°C

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
2 T_A = 25°C unless otherwise specified – T_A = 25°C wenn nicht anders angegeben
3 Non-repetitive pulse see curve I_{pp} = f (t) / P_{pp} = f (t)
Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Impulses, siehe Kurve I_{pp} = f (t) / P_{pp} = f (t)

Characteristics (T_j = 25°C)

Kennwerte (T_j = 25°C)

Type Typ	Junction capacitance Sperrschichtkapazität V _R = 0 V, f = 1 MHz	Stand-off voltage Sperrspannung	Max. rev. current Max. Sperrstrom at / bei V _{WM}	Breakdown voltage Abbruch-Spannung I _T = 1 mA	Max. clamping voltage Max. Begrenzer-Spannung at / bei I _{PPM} (8/20 μs)	
	C _j [pF]	V _{WM} [V]	I _D [μA]	V _{BR} [V]	V _c [V]	I _{PPM} [A]
ESDBK3V3	typ. 15	3.3	0.4	4 ... 6	9	7



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss